Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание		
		<u>Конденсаторы</u>				
	C1,C7	Конденсатор многослойный 10 нФ 250 В				
		±10% X7R	2			
	C2, C5,	Конденсатор многослойный 100 нФ 50 В				
	C9	±10% X7R	3			
	C3, C8,	Конденсатор многослойный 47 нФ 50 B ±10%				
	C10	X7R	3			
	C4	Конденсатор многослойный 22 мкФ 25 В				
		±20% X7R	1			
	<i>C</i> 6	Конденсатор многослойный 100 пФ 50 В				
		± 5% C0G	1			
	C11	Конденсатор многослойный 10.5 пФ 50 В				
		± 5% NP0	1			
		<u>Микросхемы</u>				
	BMS	HX-2S-JH20, система управления батареи	1			
	VCO	YSGM232508, генератор управляемый				
		напряжением	1			
	DC-DC	XL6009, преобразователь, повышающий	1			
	LVC	LM2940L-50-TN3-R, линейный регулятор				
		напряжения	1			
	LED1	0805G, светодиод зелёный 120° 100 мКд				
		474 нм	1			
	FAN1	RQU3510MS, вентилятор-улитка, 0.15 A,				
		0.75 Вт, 7000 об./мин.	1			
		<u>Резисторы</u>				
	R1, R3	Резистор SMD 1 кОм, 0.25 Bm, ±1%				
	R4		3			
		FVIAD 400201 0	024 D33			
ГУИР.400201.024 ПЭЗ Изм.Лист № докум. Подп. Дата						
Разр Прос		анова — Аппаратиный комплекс оля —	<i>Лит.</i> У	Лист         Листов           1         2		
т. ко Н. ко	т. контр. Куприянова  Н. контр. Туровец  Перечень эпементов			М, гр. 050503		
Утв. Никульшин						

Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание		
	R2, R5	Резистор SMD 150 Ом, 0.5 Вт, ±5%	2			
	R6, R11	Резистор SMD 22 кОм, 0.125 Bm, ±1%	2			
	R7	Резистор SMD 100 Ом, 1 Вт, ±5%	1			
	R8, R9	Резистор подстроечный 1 кОм, 0.5 Bm,				
		±10%	2			
	R10	Терморезистор 22 кОм, 0.5 Вт, ±2%	1			
		<u>Аккумуляторы</u>				
	B1B2	EVE-ICR18650/26V аккумулятор литий-				
		ионный, 2550 мАч, 5 А	2			
		<u>Транзисторы</u>				
	VT1VT4	MMBT2222A, NPN-Транзистор, 50 B, 0.8 A	4			
		<u>Разъемы</u>				
	RF-SMA	КН-SMA-K513-G, RF-вывод на SMA-антенну				
		шаг 2.54мм, 5 контактов	1			
	USB-C	GT-USB-7010ASV, USB 2.0 type-C female,				
		Крепление на плату	1			
				Лист		
Ш	ГУИР.400201.024 ПЭЗ					

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата